



### **Toshiba introduce i MOSFET di potenza a canale N da 60 V e da 100 V in tre nuove opzioni di package per migliorare l'efficienza delle linee di alimentazione delle apparecchiature industriali**

La nuova gamma utilizza i versatili package SOT-23F, i package ottimizzati per la dissipazione di calore TSOP6F e i package UDFN6B salvaspazio per soddisfare la crescente domanda di sistemi di alimentazione a 48 V e 24 V

**Düsseldorf, Germania, 18 giugno 2026** – Toshiba Electronics Europe GmbH (« Toshiba ») ha ampliato il proprio portafoglio di MOSFET di potenza a canale N con il lancio di nove nuovi componenti disponibili in tre tipi di package compatti ad elevata dissipazione di calore. La nuova gamma comprende tre prodotti da 100 V per linee di alimentazione a 48 V nelle apparecchiature industriali e sei prodotti da 60 V per i sistemi a 24 V.

Queste versioni costituiscono una risposta diretta alle attuali tendenze del mercato, in cui le linee di alimentazione delle apparecchiature industriali si stanno spostando dai sistemi convenzionali a 12 V e 24 V ai sistemi a 48 V per ridurre il consumo energetico. Dal momento che le correnti di spunto e i picchi di sovratensione sulle linee a 48 V possono portare la tensione oltre l'intervallo di 50-80 V, è necessario utilizzare MOSFET con una tensione nominale di 100 V per assicurare un funzionamento affidabile. Inoltre, all'aumentare delle tensioni di alimentazione, sono necessarie maggiore efficienza, minori perdite e dimensioni inferiori. In risposta a queste tendenze di mercato, Toshiba ha sviluppato prodotti per le linee a 48 V e le attuali linee mainstream a 24 V.

Per soddisfare le diverse esigenze delle moderne attrezzature industriali, questi prodotti sono disponibili in tre tipi distinti di package. I progettisti che danno priorità alla versatilità e alla facilità di implementazione possono utilizzare il package SOT-23F che misura 2,9 mm x 2,4 mm e offre una dissipazione di potenza di 1W. Per applicazioni che richiedono una maggiore dissipazione di potenza e un'eccellente dissipazione di calore, è disponibile il package TSOP6F da 1,5 W, che misura 2,9 mm x 2,8 mm. Per i progetti in cui la miniaturizzazione è fondamentale, il package UDFN6B fornisce una soluzione ultra

piccola e salvaspazio con un ingombro tipico di 2,0 mm x 2,0 mm e una potenza di dissipazione di 1,25 W.

Nonostante le dimensioni compatte, tutti e tre i tipi di package garantiscono una bassa resistenza di on ( $R_{DS(on)}$ ), che riduce significativamente il consumo energetico nell'apparecchiatura. Questa combinazione di alta efficienza, basse perdite e dimensioni ridotte consente di supportare una vasta gamma di applicazioni, dai controllori logici programmabili industriali (PLC), agli inverter/servomotori e ai server, agli elettrodomestici consumer come luci a LED, scaldabagni, depuratori d'acqua e aspirapolvere robotici.

Per le linee elettriche da 48 V, Toshiba offre i MOSFET a canale N da 100 V con una  $R_{DS(on)}$  di 198 m $\Omega$ :

[SSM3K387R](#) [SOT-23F]

[SSM6K387R](#) [TSOP6F]

[SSM6K387NU](#) [UDFN6B]

Per le linee elettriche da 24 V, Toshiba offre i MOSFET a canale N da 60 V con un  $R_{DS(on)}$  di 99 m $\Omega$ :

[SSM3K388R](#) [SOT-23F]

[SSM6K388R](#) [TSOP6F]

[SSM6K388NU](#) [UDFN6B]

Per le linee elettriche a 24 V, Toshiba offre i MOSFET a canale N da 60 V con una  $R_{DS(on)}$  di 200 m $\Omega$ :

[SSM3K389R](#) [SOT-23F]

[SSM6K389R](#) [TSOP6F]

[SSM6K389NU](#) [UDFN6B]

Toshiba continua ad espandere la propria gamma di MOSFET a canale N in risposta ai requisiti in continua evoluzione delle soluzioni di alimentazione miniaturizzate ad alta efficienza nel settore industriale.

###

### Informazioni su Toshiba Electronics Europe

[Toshiba Electronics Europe GmbH](#) (TEE) offre ai consumatori e alle aziende Europee un'ampia varietà di unità a disco rigido (HDD), oltre a soluzioni su semiconduttore per applicazioni automotive, industriali, IoT, di controllo del movimento, telecom, di rete, consumer e per gli elettrodomestici. Oltre agli hard disk, l'ampio portafoglio dell'azienda comprende semiconduttori di potenza e altri dispositivi discreti che vanno dai diodi ai circuiti integrati logici, ai semiconduttori ottici, ai microcontrollori e ai prodotti standard specifici per un'applicazione (ASSP), tra gli altri. Inoltre, TEE offre anche celle e moduli per batterie SCiB™ con ossido di litio e titanio (LTO) per applicazioni pesanti.

TEE ha la propria sede centrale a Düsseldorf, in Germania, con filiali in Francia, Italia, Spagna, Svezia e Regno Unito che forniscono servizi di marketing, vendita e logistica.

Visitate i siti Web di Toshiba all'indirizzo [www.toshiba.semicon-storage.com](http://www.toshiba.semicon-storage.com) e [www.scib.jp/en](http://www.scib.jp/en) per maggiori informazioni sull'azienda e sui suoi prodotti.

**Indirizzo di riferimento per le pubblicazioni:**

Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, D-40549 Düsseldorf, Germany

Tel: +49 (0) 211 5296 0

Web: [www.toshiba.semicon-storage.com/eu/company/news.html](http://www.toshiba.semicon-storage.com/eu/company/news.html)

**Contatto per i giornalisti:**

Michelle Shrimpton, Toshiba Electronics Europe GmbH

Tel: +44 (0)7464 493526

E-mail: [MShrimpton@teu.toshiba.de](mailto:MShrimpton@teu.toshiba.de)

**Comunicato emesso da:**

Birgit Schöniger, Pretzl

Tel: +49 (0) 172 617 8431

Web: [www.pretzl.com](http://www.pretzl.com)

E-mail: [birgit.schoeniger@pretzl.com](mailto:birgit.schoeniger@pretzl.com)

**Giugno 2026**

**Rif. 7669I**